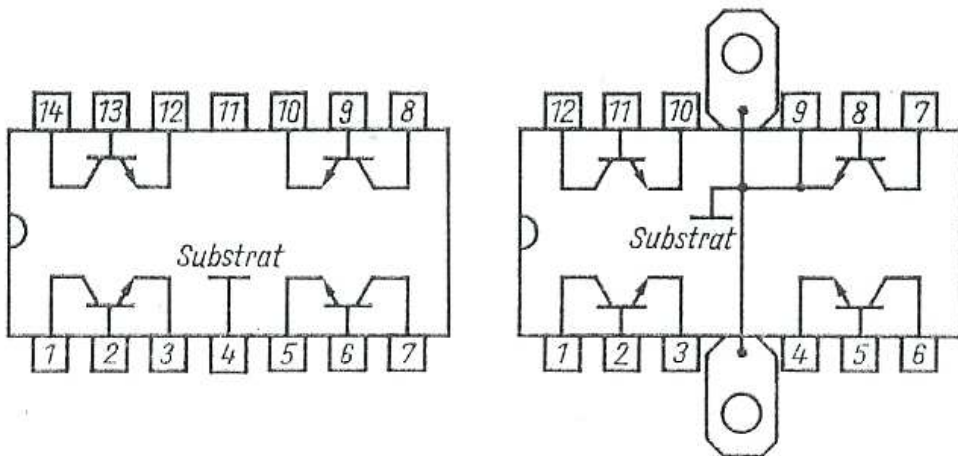


**B 315 D, E, K · B 325 D, E, K · B 360 D, E, K ·
B 380 D, E, K**

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-Transistoren ohne und mit Kühlkörper.

Bauform 5 (D-Typen)
16 (E-Typen)
17 (K-Typen)



Innere Schaltung und Anschlußbelegung

B 315 D, B 325 D, B 360 D,
B 380 D

B 315 E, K; B 325 E, K;
B 360 E, K; B 380 E, K

- 1 Kollektor T 1
- 2 Basis T 1
- 3 Emitter T 1
- 4 Substrat
- 5 Emitter T 2
- 6 Basis T 2
- 7 Kollektor T 2
- 8 Kollektor T 3
- 9 Basis T 3
- 10 Emitter T 3
- 11 frei
- 12 Emitter T 4
- 13 Basis T 4
- 14 Kollektor T 4

- 1 Kollektor T 1
- 2 Basis T 1
- 3 Emitter T 1
- 4 Emitter T 2
- 5 Basis T 2
- 6 Kollektor T 2
- 7 Kollektor T 3
- 8 Basis T 3
- 9 Emitter T 3 (Substrat)
- 10 Emitter T 4
- 11 Basis T 4
- 12 Kollektor T 4

Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

		B 315 max.	B 325 max.	B 360 max.	B 380 max.
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}	15	25	60	80 V
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CBO}	20	30	90	100 V
Emitter-Basis-Spannung	U_{EBO}			5	V
Kollektorstrom	I_C		0,5		A
Impulsspitzenstrom	I_C		1,0		A
Gesamtverlustleistung	P_{tot} (3..D)		1,3		W
	P_{tot} (3..E)		1,8		W
	P_{tot} (3..K)		4,0		W
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a		-25 ... +85		°C
Sperrschichttemperatur	ϑ_{jmax}		150		°C
Gesamtwärmewiderstand	R_{thja} (3..D)		85		K/W
	R_{thj} (3..E)		65		K/W
	R_{thja} (3..K)		30		K/W

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{K}$):

		min.	max.	
Gleichstromverstärkung ¹⁾ $U_{CE} = 3\text{V}, I_C = 50\text{mA}$	h_{21E} (T1)			
	Gruppe b	28	71	
	Gruppe c	56	140	
	Gruppe d	112	280	
	Gruppe e	224	560	
Kollektor-Basis-Reststrom	I_{CBO}		100 nA	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 50\text{mA}, I_B = 10\text{mA}$	$U_{CB} = 20\text{V}$	B 315 D, E, K		
	$U_{CB} = 30\text{V}$	B 325 D, E, K		
	$U_{CB} = 80\text{V}$	B 360 D, E, K B 380 D, E, K		
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 1\text{mA}$	$U_{(BR)CEO}$	B 315	B 352 B 360 B 380	
		15	20 60 80	
				0,5 V